(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-239037

(43)公開日 平成4年(1992)8月26日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 8 J 5/18 B 3 2 B 27/00	識別記号 CFG A	庁内整理番号 8517-4F 7717-4F	FΙ	技術表示箇所
31/00 C 0 8 G 73/10	NTF	7141-4F 8830-4 J		
C 0 9 D 179/08	PLX	8830-4 J		
0000			審査請求 未請求	₹ 請求項の数2(全 5 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願平3-12435		(71)出願人	
(00) [[[[#]	亚40年(1001) 1 1	7.10.17		日本電信電話株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)1月	∄10日	(79) 桑畑⇒	東京都千代田区内幸町1丁目1番6号
			(12)	佐々木 重邦 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内
			(72)発明者	松浦 徹
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日 本電信電話株式会社内
			(72)発明者	安藤(慎治
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(74)代理人	弁理士 中本 宏 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ポリイミド多層膜の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 低誘電率、透明性に優れた可溶性ポリイミド の多層膜の簡便な製造方法を提供する。

【構成】 有機溶媒に可溶なポリイミド膜の上層にポリ イミド膜を形成しているポリイミド多層膜の製造におい て、有機溶媒に可溶なポリイミド膜を380℃以上での 熱処理を行い形成する。

【効果】 低光損失光導波路、低誘電率多層配線板の製 造に有用である。

1

【特許請求の範囲】

有機溶媒に可溶なポリイミド膜の上層に 【請求項1】 ポリイミド膜が形成されているポリイミド多層膜の製造 において、有機溶媒に可溶なポリイミド膜を380℃以 上での熱処理を行い形成することを特徴とするポリイミ ド多層膜の製造方法。

【請求項2】 有機溶媒に可溶なポリイミド膜の少なく とも一つが、2,2'-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4′-ジアミノビフェニルを合成原料として含んで いるポリイミド、ポリイミド共重合体、又はポリイミド 10 混合物であることを特徴とする請求項1に記載のポリイ ミド多層膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、可溶性ポリイミドから なるポリイミドの多層膜の製造方法、特に電子部品、電 子・光部品、光部品に用いるポリイミドの多層膜の製造 方法に関する。

[0002]

宙・航空分野を中心に多く用いられてきている。最近で は半導体プロセス温度に耐え得るなどの優れた耐熱性の 特徴を利用し、電子部品の層間絶縁膜、多層配線板材料 などにも利用されている。これらのポリイミドには信号 の高速化の観点から低誘電率化が求められている。また 電子・光部品、光部品における光導波路としてもポリイ ミドは期待され始めており、このポリイミドには光伝送 損失が小さいことすなわち透明性が要求されている。こ のような低誘電率、透明性を有するポリイミドが最近種 々開発されている。例えばサムペ ジャーナル (SAMPE 30 JOURNAL)、7月/8月号(1985)の第28頁には いくつかの透明性ポリイミドの例が報告されている。こ れらの透明性ポリイミドの一つの特徴として溶媒に可溶 であることが述べられている。また本発明者らは特願平 1-201170号明細書で低誘電率で透明なフッ素化 ポリイミドを明らかにしている。これらのポリイミドの 多くは溶媒に可溶である。

【0003】ところでこれらの低誘電率、透明性なポリ イミドを層間絶縁膜、光導波路として用いる場合は多層 構造にすることがしばしば要求される。すなわちポリイ *40* ミド膜の上層に少なくとももう一層ポリイミド膜を形成 する必要がある。しかしながらこれらの低誘電率、透明 性のポリイミドは溶媒に可溶であるという性質があるた め、多層にするのが困難であり、これらを多層化したも のは調べる限り実現されていない。本発明者らは、これ らのポリイミド多層膜の製造方法としてポリイミドとそ の前駆体のポリアミド酸の溶媒に対する溶解性の差を利 用し、ポリイミドには不溶でポリアミド酸には可溶な溶 媒を用いてポリアミド酸溶液を作製し、可溶性ポリイミ

の製造に成功している。この製造方法は可溶性ポリイミ ドの多層膜を形成する興味ある方法であるが、ポリアミ ド酸とポリイミドの溶媒を同じものが使用できないとい う欠点もある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように可溶性ポリ イミドの多層膜を形成する方法として同一の溶媒を用い て行うことは不可能であった。本発明は低誘電率、透明 性に優れた可溶性ポリイミドの多層膜の簡便な製造方法 を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明のポリイミド多層膜の製造方法に関する発明で有機 溶媒に可溶なポリイミド膜の上層にポリイミド膜が形成 されているポリイミド多層膜の製造において、有機溶媒 に可溶なポリイミド膜を380℃以上での熱処理を行い 形成することを特徴とする。

【0006】本発明者らは、前記の目的を達成するた め、可溶性ポリイミドの熱処理温度と溶媒に対する溶解 【従来の技術】ポリイミドは耐熱性に優れているため宇 20 性の関係について検討した結果、ポリイミドの熱処理温 度をある温度以上にすることにより溶媒に対する溶解性 がなくなり、多層化が可能であるという事実を見出し、 本発明を完成するに至った。

> 【0007】本発明に使用する可溶性ポリイミドとして は、すべての可溶性ポリイミドが使用できる。例えば以 下に示すテトラカルボン酸又はその誘導体とジアミンか ら製造されるポリイミド、ポリイミド共重合体、ポリイ ミド混合物の中で溶媒に可溶なものが挙げられる。

【0008】テトラカルボン酸並びにその誘導体として の酸無水物、酸塩化物、エステル化物等としては次のよ うなものが挙げられる。ここではテトラカルボン酸とし ての例を挙げる。

【0009】 (トリフルオロメチル) ピロメリット酸、 ジ(トリフルオロメチル)ピロメリット酸、ジ(ヘプタ フルオロプロピル) ピロメリット酸、ペンタフルオロエ チルピロメリット酸、ビス {3,5-ジ(トリフルオロ メチル)フェノキシ}ピロメリット酸、2,3,3′, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸、3,3′,4, 4′-テトラカルボキシジフェニルエーテル、2, 3′, 3, 4′-テトラカルボキシジフェニルエーテ ル、3,3′,4,4′-ベンゾフェノンテトラカルボ ン酸、2,3,6,7-テトラカルボキシナフタレン、 1, 4, 5, 7-テトラカルボキシナフタレン、1, 4, 5, 6-テトラカルボキシナフタレン、3, 3['], 4, 4′-テトラカルボキシジフェニルメタン、3, 3′, 4, 4′-テトラカルボキシジフェニルスルホ ン、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)プ ロパン、2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、5,5′-ビス(トリフ ドの上層にポリイミド膜を形成させたポリイミド多層膜 50 ルオロメチル)-3, 3', 4, 4' - テトラカルボキ

シビフェニル、2, 2', 5, 5'ーテトラキス(トリ フルオロメチル) -3,3',4,4'-テトラカルボ キシビフェニル、5,5'-ビス(トリフルオロメチ ル) -3, 3', 4, 4'-テトラカルボキシジフェニ ルエーテル、5,5'-ビス(トリフルオロメチル)-3, 3', 4, 4'-テトラカルボキシベンゾフェノ ン、ビス((トリフルオロメチル)ジカルボキシフェノ キシ}ベンゼン、ビス { (トリフルオロメチル) ジカル ボキシフェノキシ (トリフルオロメチル) ベンゼン、 ビス(ジカルボキシフェノキシ)(トリフルオロメチ 10 ル) ベンゼン、ビス(ジカルボキシフェノキシ) ビス (トリフルオロメチル) ベンゼン、ビス (ジカルボキシ フェノキシ) テトラキス (トリフルオロメチル) ベンゼ ン、3,4,9,10-テトラカルボキシペリレン、 $2, 2 - \forall \lambda \{4 - (3, 4 - \forall \lambda) \}$ シ)フェニル}プロパン、ブタンテトラカルボン酸、シ クロペンタンテトラカルボン酸、2,2-ビス {4-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル}ヘキサ フルオロプロパン、ビス { (トリフルオロメチル) ジカ ルボキシフェノキシ} ビフェニル、ビス { (トリフルオ 20 ロメチル) ジカルボキシフェノキシ} ビス (トリフルオ ロメチル) ビフェニル、ビス { (トリフルオロメチル) ジカルボキシフェノキシ} ジフェニルエーテル、ビス (ジカルボキシフェノキシ) ビス (トリフルオロメチ ル) ビフェニルなどである。

【0010】ジアミンとしては、例えば次のものが挙げ られる。m-フェニレンジアミン、2, 4-ジアミノト ルエン、2, 4-ジアミノキシレン、2, 4-ジアミノ デュレン、4-(1H, 1H, 11H-エイコサフルオ ロウンデカノキシ) -1, 3-ジアミノベンゼン、4-30 (1H, 1H-パーフルオロ-1-ブタノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン、4-(1H, 1H-パーフルオ ロ-1-ヘプタノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン、 4-(1H, 1H-パーフルオロ-1-オクタノキシ) -1,3-ジアミノベンゼン、4-ペンタフルオロフェ ノキシー1, 3-ジアミノベンゼン、4-(2, 3, 5, 6-テトラフルオロフェノキシ) -1, 3-ジアミ ノベンゼン、4-(4-フルオロフェノキシ)-1,3 -ジアミノベンゼン、4-(1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロ-1-ヘキサノキシ)-1,3-ジアミノ ベンゼン、4-(1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオ ロ-1-ドデカノキシ)-1,3-ジアミノベンゼン、 p-フェニレンジアミン、(2,5-)ジアミノトルエ ン、2, 3, 5, 6 - テトラメチル - p - フェニレンジ アミン、(2,5-)ジアミノベンゾトリフルオライ ド、ビス(トリフルオロメチル)フェニレンジアミン、 ジアミノテトラ (トリフルオロメチル) ベンゼン、ジア ミノ (ペンタフルオロエチル) ベンゼン、2,5-ジア ミノ (パーフルオロヘキシル) ベンゼン、2,5-ジア ミノ (パーフルオロブチル) ベンゼン、ベンジジン、

4

2, 2′-ジメチルベンジジン、3, 3′-ジメチルベ ンジジン、3,3'-ジメトキシベンジジン、2,2' -ジメトキシベンジジン、3,3',5,5'ーテトラ メチルベンジジン、3,3'-ジアセチルベンジジン、 2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4'-ジ アミノビフェニル、3,3'-ビス(トリフルオロメチ ル) -4, 4'-ジアミノビフェニル、オクタフルオロ ベンジジン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、 4, 4′-ジアミノジフェニルメタン、4, 4′-ジア ミノジフェニルスルホン、2,2-ビス(p-アミノフ ェニル)プロパン、3,3′-ジメチル-4,4′-ジ アミノジフェニルエーテル、3,3′-ジメチル-4, 4′-ジアミノジフェニルメタン、1,2-ビス(アニ リノ) エタン、2, 2-ビス (p-アミノフェニル) へ キサフルオロプロパン、1,3-ビス(アニリノ)へキ サフルオロプロパン、1,4-ビス(アニリノ)オクタ フルオロブタン、1,5-ビス(アニリノ)デカフルオ ロペンタン、1,7-ビス(アニリノ)テトラデカフル オロヘプタン、2,2′-ビス(トリフルオロメチル) -4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,3'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミノジフ ェニルエーテル、3,3',5,5'-テトラキス(ト リフルオロメチル) - 4, 4′-ジアミノジフェニルエ ーテル、3, 3′-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4′-ジアミノベンゾフェノン、4,4′′-ジアミノ -p-テルフェニル、1,4-ビス(p-アミノフェニ ル) ベンゼン、p-ビス(4-アミノ-2-トリフルオ ロメチルフェノキシ) ベンゼン、ビス (アミノフェノキ シ) ビス (トリフルオロメチル) ベンゼン、ビス (アミ ノフェノキシ) テトラキス (トリフルオロメチル) ベン ゼン、4,4'''ージアミノーpークオーターフェニ ル、4,4′-ビス(p-アミノフェノキシ)ビフェニ ル、2,2-ビス {4-(p-アミノフェノキシ)フェ ニル}プロパン、4,4'-ビス(3-アミノフェノキ シフェニル) ジフェニルスルホン、2,2-ビス {4-(4-アミノフェノキシ)フェニル} ヘキサフルオロプ ロパン、2,2-ビス {4-(3-アミノフェノキシ) フェニル} ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス {4 - (2-アミノフェノキシ)フェニル}ヘキサフルオロ 40 プロパン、2, 2-ビス {4-(4-アミノフェノキ シ) -3, 5-ジメチルフェニル} ヘキサフルオロプロ パン、2, 2-ビス $\{4-(4-アミノフェノキシ)-$ 3、5-ジトリフルオロメチルフェニル トヘキサフルオ ロプロパン、4,4′ービス(4-アミノー2-トリフ ルオロメチルフェノキシ) ビフェニル、4,4'-ビス (4-アミノ-3-トリフルオロメチルフェノキシ) ビ フェニル、4,4'ービス(4-アミノー2-トリフル オロメチルフェノキシ)ジフェニルスルホン、4,4' ービス(3-アミノー5-トリフルオロメチルフェノキ 50 シ) ジフェニルスルホン、2, 2-ビス {4-(4-ア

6

5

3-トリフルオロメチルフェノキシ)フェニル ヘキサフルオロプロパン、ビス { (トリフルオロメチル) アミノフェノキシ} ビフェニル、ビス [{ (トリフルオロメチル) アミノフェノキシ} フェニル〕ヘキサフルオロプロパン、ジアミノアントラキノン、1, 5-ジアミノナフタレン、ビス { 2- [(アミノフェノキシ) フェニル〕ヘキサフルオロイソプロピル} ベンゼンなどである。

【0011】可溶性ポリイミド層の上層に形成されるポリイミド層としては特に限定されることなくすべてのポ *10* リイミドが使用できる。

【0012】本発明のポリイミド多層膜の製造方法としては、例えば次の方法が使用できる。シリコン、石英、ポリイミドなどの基板の上に、可溶性ポリイミド又はその前駆体であるポリアミド酸を溶媒に溶かした溶液をスピンコートなどの方法により塗布し、有機溶媒に不溶となる所定の温度条件でキュアを行い、ポリイミド膜を得る。次に一層目のポリイミド膜の上に二層目を形成しようとするポリイミドの前駆体であるポリアミド酸溶液を得る。このポリアミド酸溶液をスピンコートなどの方法 20により塗布後、キュアし二層目を得る。必要があれば同様にして、三層目以上の多層膜を形成する。

【0013】本発明では可溶性ポリイミドの熱処理温度を一定条件にするところに特徴があり、その他の製造方法に関する点は一般のポリイミド多層膜の製造方法が使用できる。

[0014]

【実施例】以下いくつかの実施例を用いて本発明を更に 詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され るものではない。

【0015】実施例1

表面が酸化シリコン層である直径3インチのシリコンウ ェハ上にジアミンとして2,2'-ビス(トリフルオロ メチル) -4,4'-ジアミノビフェニル、酸無水物と して2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)-ヘキサフルオロプロパン二無水物を用いて製造した可溶 性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸の15wt% N, N-ジメチルアセトアミド溶液を加熱後の膜厚が1 0 μmになるようにスピンコート法により塗布した後最 高温度が380℃以上になるように熱処理をした。この ようにして1層目の可溶性ポリイミドから得られるポリ イミド膜を作製した。次に同じポリアミド酸溶液を加熱 後の膜厚が10μmになるようにスピンコート法により 塗布した後最高温度350℃で熱処理をした。その結果 膜厚20μmの可溶性ポリイミドの二層膜が形成でき た。二層膜の断面を走査型電子顕微鏡で観察した結果、 両層の界面が溶媒に侵されることなく形成していること を確認した。

20 【0016】実施例2~9

実施例1において第1層の可溶性ポリイミドの前駆体のポリアミド酸及び第2層のポリイミドの前駆体のポリアミド酸として2、2´ービス(トリフルオロメチル)-4、4´ージアミノビフェニルと表1に記した酸無水物から製造されるポリアミド酸を用いて、実施例1と同様に行い、膜厚20 μ mのポリイミドの二層膜を形成することができた。

[0017]

【表1】

表 1

実施例	第1層可溶性ポリイミド前駆 体に使用した酸無水物	第2層ポリイミド前駆体に使 用した酸無水物
実施例2	6 FDA: PMDA=1:0	6 F D A : P M D A = 9 : 1
実施例3	6 FDA: PMDA=1:0	6 FDA: PMDA=8:2
実施例4	6 FDA: PMDA=1:0	6 FDA: PMDA=7:3
実施例5	6 FDA: PMDA=1:0	6 FDA: PMDA=6:4
実施例6	6 FDA: PMDA=9:1	6 FDA: PMDA=1:0
実施例7	6 FDA: PMDA=9:1	6 FDA: PMDA=9:1
実施例8	6 FDA: PMDA=9:1	6 FDA: PMDA=8:2
実施例9	6 FDA: PMDA=8:2	6 FDA: PMDA=7:3

7

*6FDA; 2, 2-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) - ヘキサフル

FΙ

オロプロパン二無水物

*PMDA;ピロメリット酸二無水物

【0018】実施例10

実施例 1 で得られたポリイミド二層膜を380 $\mathbb C$ で1時間熱処理をした後その上層に、実施例 1 で使用した可溶性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸溶液を加熱後の膜厚が 10μ mになるようにスピンコート法により塗布した後最高温度 350 $\mathbb C$ で熱処理をした。その結果膜厚 30μ mの可溶性ポリイミドの三層膜が形成できた。三層膜の断面を走査型電子顕微鏡で観察した結果、各層の界面が溶媒に侵されることなく形成していることを確認した。

【0019】比較例1

実施例1において第1層目のポリイミド膜の作製で熱処理温度を350℃、熱処理時間を1時間として、実施例1と同様に多層膜の作製を試みた。しかし1層目の可溶性ポリイミド膜が溶解し、多層膜は作製できなかった。【0020】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば1 10 層目の可溶性ポリイミドの熱処理時間を380℃以上に することにより容易にポリイミド多層膜が提供できる。 本発明による多層膜を用いて低光損失埋め込み型ポリイ ミド光導波路、低誘電率ポリイミド多層配線板などの製 造が可能である。

フロントページの続き

// C08L 79:08

(51) Int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

H 0 5 K 1/03

D 7011-4E

8830-4 J

技術表示箇所